

坪山回收运放IC，电源IC

产品名称	坪山回收运放IC，电源IC
公司名称	深圳市邵昕电子科技有限公司
价格	88.88/个
规格参数	
公司地址	深圳市福田区华强北街道佳和华强大厦
联系电话	0135-30101390 13530101390

产品详情

坪山回收运放IC，电源IC，

按种类分U盘、CF卡、SM卡、SD/MMC卡、记忆棒、XD卡、MS卡、TF卡、PCIe闪存卡按品牌分砂统（SIS）、金士顿、索尼、LSI、闪迪、Kingmax、鹰泰、创见、爱国者、纽曼、威刚、联想、台电、微星、SK、三星、海力士Sandisk【NAND型闪存】内存和NOR型闪存的基本存储单元是bit，用户可以随机访问任何一个bit的信息。而NAND型闪存的基本存储单元是页（Page）（可以看到，NAND型闪存的页就类似硬盘的扇区，硬盘的一个扇区也为512字节）。每一页的有效容量是512字节的倍数。所谓的有效容量是指用于数据存储的部分，实际上还要加上16字节的校验信息，因此我们可以在闪存厂商的技术资料当中看到“（512+16）Byte”的表示方式。2Gb以下容量的NAND型闪存绝大多数是（512+16）字节的页面容量，2Gb以上容量的NAND型闪存则将页面容量扩大到（2048+64）字节。NAND型闪存以块（sector）为单位进行擦除操作。闪存的写入操作必须在空白区域进行，如果目标区域已经有数据，必须先擦除后写入，因此擦除操作是闪存的基本操作。一般每个块包含32个512字节的页（page），容量16KB；而大容量闪存采用2KB页时，则每个块包含64个页，容量128KB。每颗NAND型闪存的I/O接口一般是8条，每条数据线每次传输（512+16）bit信息，8条就是（512+16）×8bit，也就是前面说的512字节。但较大容量的NAND型闪存也越来越多地采用16条I/O线的设计，如三星编号K9K1G16U0A的芯片就是64M×16bit的NAND型闪存，容量1Gb，基本数据单位是（256+8）×16bit，还是512字节。寻址时，NAND型闪存通过8条I/O接口数据线传输地址信息包，每包传送8位地址信息。由于闪存芯片容量比较大，一组8位地址只够寻址256个页，显然是不够的，因此通常一次地址传送需要分若干组，占用若干个时钟周期。NAND的地址信息包括列地址（页面中的起始操作地址）、块地址和相应的页面地址，传送时分别分组，至少需要三次，占用三个周期。随着容量的增大，地址信息会更多，需要占用更多的时钟周期传输，因此NAND型闪存的一个重要特点就是容量越大，寻址时间越长。而且，由于传送地址周期比其他存储介质长，因此NAND型闪存比其他存储介质更不适合大量的小容量读写请求。[1] 而比我们平常用的U盘存储量更大，速度更快的闪存产品要属PCIe闪存卡了，它采用低功耗，高性能的闪存存储芯片，以提高应用程序性能。由于它们直接插到服务器中，数据位置接近服务器的处理器，相比其它通过基于磁盘的存储网络路径来获取信息大大节省了时间。企业正在转向这种技术以解决存储密集型工作负载，比如事务处理应用。在PCIe闪存卡方面，LSI公司新的Nytro产品，扩大其基于闪存的应用加速技术到各种规模的企业。LSI推出了三款产品，到一个正变得越来越拥挤的PCIe闪存适配器卡市场。LSI Nytro产品战略中的一部分，LSI公司的WarpDrive卡上，采用闪存存储、LSI的SAS集成控制器和来自公司收购的闪存控制器制造商SandForce的技术。其第二代基于PCIe的应用加速卡容量从200GB到3.2TB不等。Nytro XD应用加速存储解

决方案的软件和硬件的组合。它集成了WarpDrive卡与Nytro XD智能高速缓存软件，以提高在存储区域网络(SAN)和直接附加存储(DAS)实现中的I/O速度。还有Nytro MegaRAID应用加速卡，它结合了MegaRAID控制器与板载闪存和缓存软件，LSI公司将Nytro MegaRAID的定位面向低端，针对串行连接SCSI(SAS)DAS环境的性能增强解决方案。微软的SQL Server产品管理主管Claude Lorensen，看好LSI的闪存产品在微软服务器环境中的未来。因为LSI的闪存产品Nytro MegaRAID可以帮助微软SQL实现了每秒交易的10倍增长，[1]“闪存存储技术，如LSI的Nytro应用加速产品组合，可以用来加速关键业务应用，如SQL Server 2012”，Lorensen在一份公司的声明中表示“随着微软将在Windows Server 8中提供的增强，这些技术的重要性将继续增长。”

存储原理编辑 播报要讲解闪存的存储原理，还是要从EPROM和EEPROM说起。EPROM是指其中的内容可以通过特殊手段擦去，然后重新写入。其基本单元电路（存储细胞），常采用浮空栅雪崩注入式MOS电路，简称为FAMOS。它与MOS电路相似，是在N型基片上生长出两个高浓度的P型区，通过欧姆接触分别引出源极S和漏极D。在源极和漏极之间有一个多晶硅栅极浮空在SiO₂绝缘层中，与四周无直接电气联接。这种电路以浮空栅极是否带电来表示存1或者0，浮空栅极带电后（譬如负电荷），就在其下面，源极和漏极之间感应出正的导电沟道，使MOS管导通，即表示存入0。若浮空栅极不带电，则不形成导电沟道，MOS管不导通，即存入1。在源极和漏极之间电流单向传导的半导体上形成贮存电子的浮动栅。浮动栅包裹着一层二氧化硅膜绝缘体。它的上面是在源极和漏极之间控制传导电流的选择/控制栅。数据是0或1取决于在硅底板上形成的浮动栅中是否有电子。有电子为0，无电子为1。闪存就如同其名字一样，写入前删除数据进行初始化。具体说就是从所有浮动栅中导出电子。即将所有数据归“1”。写入时只有数据为0时才进行写入，数据为1时则什么也不做。写入0时，向栅电极和漏极施加高电压，增加在源极和漏极之间传导的电子能量。这样一来，电子就会突破氧化膜绝缘体，进入浮动栅。读取数据时，向栅电极施加一定的电压，电流大为1，电流小则定为0。浮动栅没有电子的状态（数据为1）下，在栅电极施加电压的状态时向漏极施加电压，源极和漏极之间由于大量电子的移动，就会产生电流。而在浮动栅有电子的状态（数据为0）下，沟道中传导的电子就会减少。因为施加在栅电极的电压被浮动栅电子吸收后，很难对沟道产生影响。